

СОВЕЩАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

538.945(048)

**НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ  
АКАДЕМИИ НАУК СССР**

**(21 сентября 1988 г.)**

21 сентября 1988 г. в Институте физических проблем им. С. И. Вавилова АН СССР состоялась научная сессия Отделения общей физики и астрономии АН СССР. На сессии были заслушаны доклады:

1. Л. П. Горьков. Дальнейшие исследования в области ВТСП (обзор).

2. Л. Н. Булаевский, В. Л. Гинзбург, А. А. Собянин, А. А. Стратонников. Макроскопическая теория бездефектных и дефектных сверхпроводников с малой длиной когерентности.

Краткое содержание одного доклада приводится ниже.

538.945(048)

**Л. Н. Булаевский, В. Л. Гинзбург, А. А. Собянин и А. А. Стратонников.**

Макроскопическая теория бездефектных и дефектных сверхпроводников с малой длиной когерентности. У известных до 1986 г. «обычных» сверхпроводников с критической температурой  $T_c < 25$  К экстраполированная к нулю температуры длина когерентности  $\xi(0) \equiv \xi_0$  значительно превосходит характерное межатомное или межэлектронное расстояние  $d \sim 10^{-8} - 10^{-7}$  см. Поэтому критическая область вблизи  $T_c$ , в которой значительны флуктуации, оказывается малой. По последней причине обычно практически везде вблизи  $T_c$  применима теория среднего поля и, конкретно, макроскопическая Гинзбурга — Ландау (ГЛ), или  $\Psi$ -теория сверхпроводимости<sup>1</sup>. Напротив, у обнаруженных в 1986 г. высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), по имеющимся данным, длина  $\xi_0$  невелика, так что отношение  $\xi_0/d$  не может, вообще говоря, считаться большим. В этой связи совершенно независимо от основной в настоящее время проблемы теории — выяснения природы и механизма ВТСП, актуальна задача создания макроскопической теории сверхпроводимости, учитывающей флуктуационные эффекты, и пригодной, в частности, в критической области.

Малость длины  $\xi_0$  влечет за собой и еще одну важную особенность ВТСП, а именно: аномально сильное влияние на их физические свойства различных границ (в том числе границы металл — вакуум) и дефектности образца, выражющейся в присутствии в нем двойников, зерен, дислокаций и даже отдельных «точечных» дефектов (примеси, междоузельные атомы и т. п.). Разумеется, дефекты оказывают влияние и на свойства «обычных» сверхпроводников, но там это влияние проявляется, как правило, усредненно (поскольку обычно расстояние между дефектами  $L \ll \xi_0$ ) либо очень близко к  $T_c$  (например, для границы с вакуумом при  $|t| = |T - T_c| \ll (d/\xi_0)^2$ ;

см. <sup>2</sup>). Напротив, в ВТСП условия  $L \ll \xi_0$  и  $(d/\xi_0)^2 \ll 1$  во многих случаях нарушаются, что не дает возможности пренебречь влиянием границ и дефектов или учитывать их усредненно.

Наконец, почти все известные нам ВТСП отличает весьма сильная анизотропия критических магнитных полей и других параметров. Это обстоятельство, конечно, также нужно учитывать при построении макроскопической теории.

Ниже мы сможем остановиться лишь на некоторых основных вопросах, а подробно соответствующие проблемы рассматриваются в статьях <sup>3,4</sup>.

**Основы теории.** В теории <sup>1,5</sup> параметр порядка представляет собой скалярную функцию  $\Psi = \eta e^{i\phi}$  (в таких случаях говорят об S-спаривании, а параметр порядка называют двухкомпонентным). В принципе, не исключено существование ВТСП с более сложными параметрами порядка <sup>6,7</sup>. Обобщение теории на такие случаи актуально, но здесь ограничимся рассмотрением лишь S-спаривания. Таким образом, в основу будет положено выражение для свободной энергии <sup>5</sup>

$$F = F_n + \int \left[ \frac{\mathbf{B}^2}{8\pi} + a|\Psi|^2 + \frac{b}{2}|\Psi|^4 + \frac{1}{4m_l^*} \left| \left( -i\hbar\nabla_l - \frac{2e}{c} A_l \right) \Psi \right|^2 \right] dV; \quad (1)$$

здесь  $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$  — вектор магнитной индукции,  $F_n$  — свободная энергия нормального состояния,  $a = \alpha t$ ,  $t = (T - T_c)/T_c$  — относительное расстояние до  $T_c$ ,  $2m_l^* = \{2m_x^*, 2m_y^*, 2m_z^*\}$  — главные значения тензора эффективных масс сверхпроводящих пар электронов (с зарядом  $2e$ ). Очевидно, при  $m_x^* = m_y^* = m_z^*$  мы имеем дело с  $\Psi$ -теорией изотропных сверхпроводников <sup>1</sup>. Далее, в (1)  $\alpha$  и  $b$  — некоторые положительные постоянные,  $\hbar$  — постоянная Планка и  $c$  — скорость света. Наконец, в (1) и ниже координатные оси предполагаются направленными вдоль главных осей симметрии кристалла, а по повторяющемуся индексу  $l = \{x, y, z\}$  нужно произвести суммирование.

Равновесное (наиболее вероятное) значение  $\Psi = \Psi_e$  отвечает минимуму  $F$  и находится из решения уравнений

$$\frac{1}{4m_l^*} \left( -i\hbar\nabla_l - \frac{2e}{c} A_l \right)^2 \Psi + a\Psi + b|\Psi|^2\Psi = 0, \quad (2)$$

$$\text{rot } \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad (3)$$

$$j_l = -\frac{i\hbar}{2m_l^*} (\Psi^* \nabla_l \Psi - \Psi \nabla_l \Psi^*) - \frac{2e^2}{m_l^* c} |\Psi|^2 A_l; \quad (4)$$

здесь  $\mathbf{j}$  — плотность сверхпроводящего тока (плотность нормального тока считаем равной нулю).

Границные условия к уравнениям (2) — (4) сводятся к условию непрерывности всех компонент вектора индукции  $\mathbf{B}$  на границе сверхпроводника и некоторому граничному условию на функцию  $\Psi$ . В качестве последнего» на границе сверхпроводник-вакуум (диэлектрик) используется обычно условие (поле  $\mathbf{B}$  для простоты ниже полагаем равным нулю)

$$\frac{d\Psi}{dn} \Big|_S = 0, \quad (5)$$

а на границе сверхпроводник-нормальный металл — более общее условие

$$n_l \Lambda_l \frac{\partial \Psi}{\partial x_l} \Big|_S = \Psi_S, \quad (6)$$

где  $n_l$  — компоненты единичного вектора нормали к границе сверхпроводника, а  $\Lambda_l$  — параметры размерности длины, называемые часто длинами экстраполяции.

В ВТСП условие типа (6) необходимо, по-видимому, использовать и на границе с вакуумом, а также на границах ядер любых плоских, линейных и точечных дефектов подобно тому, как это делают для сверхтекучего <sup>8</sup>

и других фазовых переходов второго рода<sup>9,10</sup>, где, вообще говоря, отношение  $\Lambda/\xi_0 \sim \xi_0/d \sim 1$ .

Обобщение на случай предельно сильной анизотропии. Для очень сильно анизотропных (слоистых) сверхпроводников приближение сплошной среды в направлении  $z$ , перпендикулярном слоям, неприменимо, и тогда вместо функционала (1) используют дифференциально-разностный функционал<sup>11,12</sup>

$$F = F_n + \sum_{j=1}^N \left\{ \int \left[ \frac{\mathbf{B}^2}{8\pi} + a|\Psi_j|^2 + \frac{b}{2}|\Psi_j|^4 + \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{4m_i^*} \left| \left( -i\hbar\nabla_l - \frac{2e}{c}A_l \right) \Psi_j \right|^2 + r\alpha(|\Psi_j - \Psi_{j-1}|^2 + |\Psi_{j+1} - \Psi_j|^2) \right] d\mathbf{p} \right\}. \quad (7)$$

Здесь радиус-вектор  $\mathbf{p}$  лежит в плоскости слоев  $(x, y)$ ,  $j$  — номер слоя,  $l = \{x, y\}$ , а безразмерная положительная константа  $r$  характеризует «силу» джозефсоновского взаимодействия между значениями параметра порядка  $\Psi_j(\mathbf{p})$  в соседних слоях.

При  $r \gg |t|$  функционал (7) переходит в трехмерный анизотропный функционал (1), а предел  $r \rightarrow 0$  отвечает чисто двумерной сверхпроводимости. В ВТСП иттриевого и лантанового ряда экспериментальное значение  $r \sim 1$ , так что вблизи  $T_c$  их можно считать обычными трехмерными сверхпроводниками.

Учет тепловых флюктуаций. Строгий метод изучения тепловых флюктуаций, лежащий в основе современной флюктуационной теории фазовых переходов второго рода, состоит в использовании функционала (1) или<sup>13</sup> (7) в качестве эффективного гамильтониана, определяющего вероятность

$$w \propto \exp \left\{ -\frac{1}{k_B T} (F[\Psi(\mathbf{r})] - F[\Psi_e(\mathbf{r})]) \right\} \quad (8)$$

найти систему в состоянии с заданной функцией  $\Psi(\mathbf{r})$ , отличной от равновесной (наиболее вероятной) функции  $\Psi_e(\mathbf{r})$ .

При приближенном подходе, хорошо оправдывающем себя вблизи точки сверхтекущего  $\lambda$ -перехода в  ${}^4\text{He}$  (см.<sup>14</sup>), флюктуационные эффекты можно в значительной мере учесть, видоизменяя в функционале (1) температурную зависимость коэффициентов. При этом в области малых (гауссовых) флюктуаций<sup>3,15</sup>

$$a \rightarrow \alpha t \left[ 1 + \frac{3}{4} \left( \frac{t_G}{|t|} \right)^{1/2} \right], \\ b \rightarrow b_0 \left[ 1 - \frac{9}{4} \left( \frac{t_G}{|t|} \right)^{1/2} \right], \\ \frac{1}{m_i^*} \rightarrow \frac{1}{m_{i,0}^*} \left[ 1 + \frac{3}{16} \left( \frac{t_G}{|t|} \right)^{1/2} \right], \quad (9)$$

а в области больших (критических) флюктуаций<sup>3,14</sup>

$$a \rightarrow \alpha t \left( \frac{|t|}{t_G} \right)^{1/3}, \quad b \rightarrow b_0 \left( \frac{|t|}{t_G} \right)^{2/3}, \quad \frac{1}{m_i^*} \approx \text{const.} \quad (10)$$

Кроме того, поскольку в критической области коэффициенты  $a$  и  $b$  обращаются в нуль при  $t \rightarrow 0$ , то в (1) нужно добавить член  $(1/3)g|\Psi|^6$  с положительным постоянным коэффициентом  $g$ .

В выражениях (9) величина  $t_g$  определяет ширину области больших флюктуаций и связана со скачком теплоемкости  $\Delta C_p$  при  $T = T_c$  и средней длиной когерентности  $\bar{\xi}_0 = (\xi_{0x}\xi_{0y}\xi_{0z})^{1/3}$  соотношением<sup>3</sup>

$$t_g = \frac{1}{32\pi^2} \left( \frac{k_B}{\Delta C_p \xi_0^3} \right)^2. \quad (11)$$

Величину  $t_g$  можно также определить непосредственно из измерений амплитуды  $C_0^\pm$  первой (гауссовой) флюктуационной поправки  $C_{\text{fl}} = C_0^\pm / |t|^{1/2}$  к теплоемкости при  $t > 0$  или  $t < 0$ :

$$t_g = \left( \frac{C_0^-}{\Delta C_p} \right)^2 = 2 \left( \frac{C_0^+}{\Delta C_p} \right)^2. \quad (12)$$

В частности, из данных<sup>16</sup> следует, что в монокристаллах  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  параметр  $t_g \sim 10^{-3}$ , т. е. ширина критической области здесь лишь порядка 0,1 К. Тем не менее вклад флюктуационных эффектов в  $C_p$  вполне заметен и достигает 10% от  $\Delta C_p$  при  $|T - T_c| \sim 10$  К, а при  $|T - T_c| \sim 1$  К он составляет уже ~30%.

Наиболее яркий вывод флюктуационной теории состоит в том, что внутри флюктуационной области отношение  $\kappa$  глубины проникновения магнитного поля  $\delta$  к длине когерентности  $\xi$  должно уменьшаться при  $T \rightarrow T_c$  и, таким образом, в достаточной близости к  $T_c$  сверхпроводник второго рода должен превращаться в сверхпроводник первого рода. К сожалению, в известных ВТСП исходное значение  $\kappa$  вдали от  $T_c$  велико, и этот эффект вряд ли можно наблюдать экспериментально.

**Влияние границ и дефектов.** В граничном условии (6), остающемся справедливым и в критической области, знак параметра  $\Lambda$  заранее не определен и может быть, в принципе, как положительным, так и отрицательным. Особенno интересен последний случай, так как тогда сверхпроводимость появляется первоначально при некоторой температуре  $T'_c > T_c$  в узком слое вблизи границы (или в малой области вблизи ядра дефекта) с характерной толщиной  $\xi(t'_c) = \xi_{0x} |t'_c|^{-1/2}$ , где  $t'_c = (T'_c - T_c) \times (T_c)^{-1}$ . При понижении температуры этот слой расширяется, а при  $T < T_c$  сверхпроводимость распространяется на весь кристалл.

Явление такой «локальной» сверхпроводимости наблюдалось вблизи границ двойников во многих «обычных» сверхпроводниках<sup>17</sup>. Вполне вероятно поэтому, что оно должно иметь место и в ВТСП, где плоскости двойникования (ПД) присутствуют, как правило, в очень большом количестве. В пользу последнего предположения говорит большое число экспериментальных фактов<sup>18-20</sup> и особенно данные<sup>16,21</sup> измерений теплоемкости в «монокристаллах»  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ , детально анализировавшиеся в работе<sup>4</sup>. На рис. 1 и 2 дано сравнение результатов расчетов<sup>4</sup> (основанных на выражениях (1) — (6) и учитывавших гауссовые флюктуационные эффекты) с экспериментальными данными<sup>16,21</sup> в нулевом внешнем магнитном поле и в поле с напряженностью 30 кЭ.

Хорошее совпадение экспериментальных и расчетных кривых подтверждает правильность исходного предположения о некотором усилении сверхпроводимости вблизи ПД. Кроме того, из сравнения с данными<sup>16,21</sup> можно рассчитать значения всех фигурирующих в (1) параметров сверхпроводника, а также оценить величину параметра  $\Lambda$  и среднее расстояние между двойниками  $L$ . Значения этих величин таковы ( $m_e$  — масса свободного электрона):  $\Lambda \approx -75$  Å,  $L \approx 1500$  Å,  $\bar{\xi}_0 = 8 \pm 0,5$  Å,  $\xi_{0x} \approx \xi_{0y} = 15 \pm 3$  Å,  $\xi_{0z} \approx 2 \pm 0,5$  Å,  $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-14}$  эрг,  $b = 4,0 \cdot 10^{-36}$  эрг·см<sup>3</sup>,  $m_x \approx m_y \approx \approx (10 - 14) m_e$ ,  $m_z \approx (250 - 1500) m_e$ .

При получении четырех последних значений мы пренебрегли возможной слабой анизотропией эффективных масс в плоскости слоев Cu — O и норми-

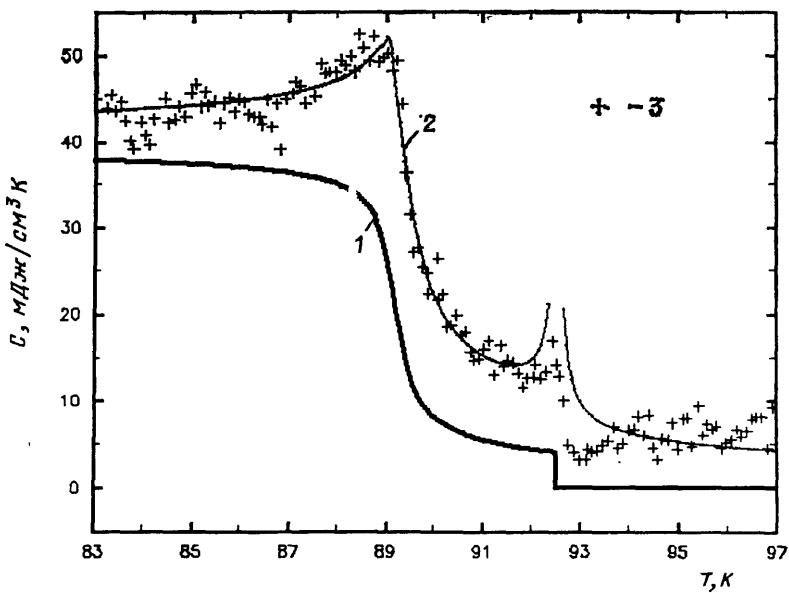


Рис. 1. Температурная зависимость сверхпроводящего вклада в теплоемкость для одного из исследовавшихся в <sup>16</sup> («аргентинского») кристалла  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$  в нулевом внешнем магнитном поле. 1 — результаты теоретических вычислений <sup>4</sup> без учета флуктуационных эффектов при следующих значениях параметров:  $\Delta C_p = 14 \text{ мДж/см}^3\text{К}$ ,  $L/\xi_{0x} = 100$ ,  $\Lambda/\xi_{0x} = -5$ ; 2 — то же при учете тепловых флуктуаций и  $\xi_0 = 9 \text{ \AA}$ ; 3 — экспериментальные данные <sup>16</sup>

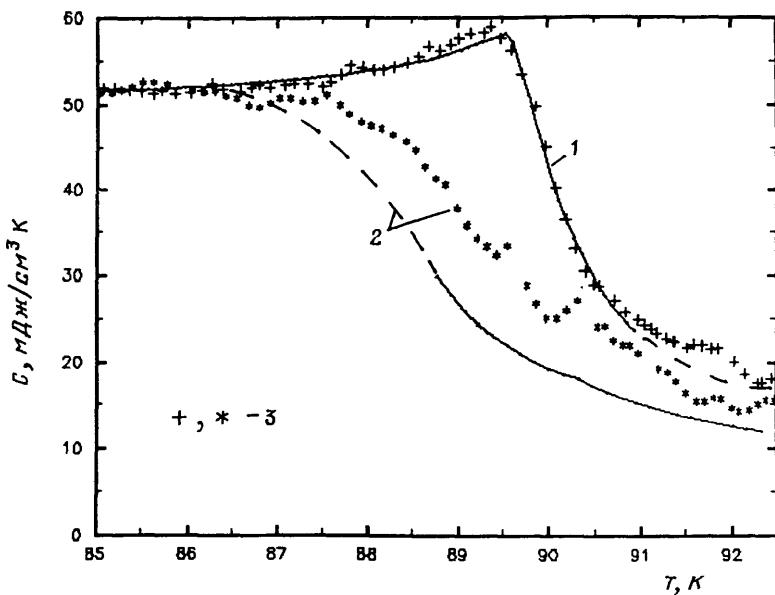


Рис. 2. Температурная зависимость сверхпроводящего вклада в теплоемкость для «иллинойского» кристалла. 1 — в поле  $H = 0$ , 2 — в поле  $H = 30 \text{ кОe}$ . Сплошные кривые — результаты теоретических вычислений <sup>4</sup> при  $\Delta C_p = 42 \text{ мДж/см}^3\text{К}$ ,  $\xi_0 = 8 \text{ \AA}$ ,  $L/\xi_{0x} = 87$ ,  $\xi_{0x}/\xi_{0z} = 8$ ,  $\Lambda/\xi_{0x} = -5$ . Штриховые кривые — экстраполяция расчетных кривых в те области температур, где строгий расчет затруднен. 3 — экспериментальные данные <sup>16,21</sup>

ровали параметр порядка на концентрацию сверхпроводящих пар при нулевой температуре  $n_s(0) = \alpha/b = 3 \cdot 10^{21} \text{ см}^{-3}$ , что соответствует приблизительно половине пары на элементарную ячейку. Отметим, что такой выбор

нормировки  $\Psi$ , конечно, условен и не сказывается ни на каких физических результатах теории.

Выводы. Выше мы рассмотрели некоторые особенности макроскопической теории ВТСП и продемонстрировали ее эффективность на примере интерпретации экспериментальных данных о критической аномалии теплоемкости в кристаллах  $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ . Макроскопическая теория не чувствительна к конкретным микроскопическим механизмам сверхпроводимости, и в этом плане она проще и надежнее, чем микроскопическая теория. Вместе с тем, и в области макроскопической теории ВТСП имеется еще ряд нерешенных вопросов. Один из таких вопросов связан с возможной реализацией в некоторых ВТСП более сложных типов сверхпроводящих фаз, описываемых векторным или тензорным параметром порядка и напоминающих сверхтекущие фазы  $^3He$ . Описание <sup>6,7</sup> таких фаз было бы в ряде отношений иным, чем рассмотренное выше макроскопическое описание «скалярной» сверхпроводимости.

Второй очень важный вопрос касается отмеченной недавно в <sup>22</sup> возможной неприменимости в случае сверхпроводников с очень сильным запаздывающим электрон-фононным взаимодействием классических методов учета флуктуаций, базирующихся на формуле (8) и хорошо зарекомендовавших себя для всех других фазовых переходов второго рода.

Выяснение этих вопросов и, главное, проверка различных выводов макротеории представляют большой интерес и требуют дальнейших экспериментальных и теоретических исследований.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- <sup>1</sup> Гинзбург В. Л., Ландау Л. Д.//ЖЭТФ. 1950. Т. 20. С. 1064.
- <sup>2</sup> Де Жен П. Сверхпроводимость металлов и сплавов.—М.: Мир, 1968.
- <sup>3</sup> Булаевский Л. Н., Гинзбург В. Л., Собянин А. А.//ЖЭТФ. 1988. Т. 94. С. 355; Physica. Ser. C. 1988. V. 152. P. 378.
- <sup>4</sup> Собянина А. А., Стратонников А. А.//Ibidem. V. 153—155. P. 1681; ЖЭТФ. 1989, т. 95.
- <sup>5</sup> Гинзбург В. Л.//ЖЭТФ. 1952. Т. 23. С. 236.
- <sup>6</sup> Воловик Г. Е., Горьков Л. П.//ЖЭТФ. 1985. Т. 88. С. 1412.
- <sup>7</sup> Марченко В. И.//ЖЭТФ. 1987. Т. 93. С. 583.
- <sup>8</sup> Собянин А. А.//ЖЭТФ. 1971. Т. 61. С. 433.
- <sup>9</sup> Каганов М. И., Омельянчук А. Н.//Ibidem. С. 1679.
- <sup>10</sup> Собянин А. А., Стратонников А. А. ЖЭТФ. 1984. Т. 87. С. 1442.
- <sup>11</sup> Lawrence W. E., Doniach S.//Proc. of 12th Conference on Low Temperature Physics (LT-12).—Kyoto, Japan, 1970.—P. 361.
- <sup>12</sup> Булаевский Л. Н.//УФН. 1975. Т. 116. С. 449.
- <sup>13</sup> Гинзбург В. Л.//ФТТ. 1960. Т. 2. С. 2031.
- <sup>14</sup> Гинзбург В. Л., Собянин А. А.//УФН. 1976. Т. 120. С. 153; 1988. Т. 154. С. 545.
- <sup>15</sup> Вакс В. Г., Ларкин А. И., Пикин С. А.//ЖЭТФ. 1966. Т. 51. С. 361.
- <sup>16</sup> Inderhees S. E., Salamon M. B., Goldenfeld N., Rice J. P., Pazzoli P. G., Ginsberg D. M., Lin J. Z., Grabtree G. W.//Phys. Rev. Lett. 1988. V. 60. P. 1178.
- <sup>17</sup> Хлюстиков И. Н., Буздин А. И.//УФН. 1988. Т. 155. С. 47.
- <sup>18</sup> Fang M. M., Kogan V. G., Finnemore D. K., Clem J. R., Chambley L. S., Farrell D. E.//Phys. Rev. Ser. B. 1988. V. 37. P. 2334.
- <sup>19</sup> Athreya K., Hyun O. B., Ostenson J. E., Clem J. R., Finnemore D. K. Preprint IS-J 3008.—Iowa State Univ., 1988.
- <sup>20</sup> Vieira S., Zhou P., Solin S. A., Garcia N., Hortal M., Aguilera A. Preprint.—Michigan State Univ., 1988.
- <sup>21</sup> Ginsberg D. M., Inderhees S. E., Salamon M. B., Goldenfeld N., Rice J. P., Pazzoli B. G.//Physica Ser. C. 1988. V. 153—155. P. 1082.
- <sup>22</sup> Bulaevskii L. N., Dolgov O. V.//Sol. State Commun. 1988. V. 67. P. 63.